

2SK777



2056

NチャネルMOS形
シリコン電界効果トランジスタ

超高速スイッチング用

②2561

特長 ・低オン抵抗、超高速スイッチング。

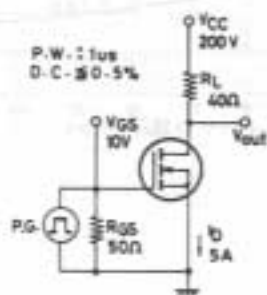
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^{\circ}\text{C}$

			unit
ドレイン-ソース電圧	V_{DS}	450	V
ゲート-ソース電圧	V_{GS}	± 20	V
ドレイン電流(D.C.)	I_D	10	A
ドレイン電流(Puls.)	$I_{D\text{ peak}}$	20	A
許容損失	P_D	$T_c=25^{\circ}\text{C}$	120 W
接合部温度	T_j		150 $^{\circ}\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}		$-55 \sim +150$ $^{\circ}\text{C}$

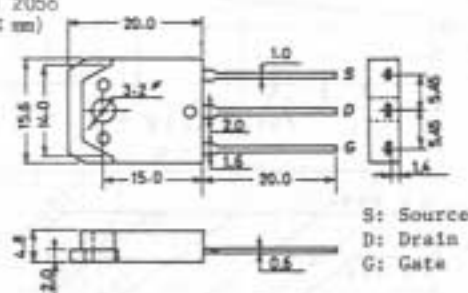
電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^{\circ}\text{C}$

			min	typ	max	unit
ドレイン-ソース降伏電圧	V_{DS}	$I_D=1\text{mA}, V_{GS}=0$	450			V
ドレイン-ソースしきり電流	I_{DSS}	$V_{DS}=450\text{V}, V_{GS}=0$			1.0	mA
ゲート-ソースしきり電流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20\text{V}, V_{DS}=0$			± 100	nA
ゲート-ソースしきり電圧	$V_{GS}(\text{off})$	$V_{DS}=10\text{V}, I_D=1\text{mA}$	1.5		4.0	V
順伝達アミタス	$ Y_{fs} $	$V_{DS}=10\text{V}, I_D=5\text{A}$	3	4.5		S
飽和抵抗	$R_{DS(\text{on})}$	$I_D=5\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$		0.47	0.65	Ω
入力容量	C_{iss}	$V_{DS}=20\text{V}, f=1\text{MHz}$		1600		pF
出力容量	C_{oss}	$V_{DS}=20\text{V}, f=1\text{MHz}$		250		pF
帰還容量	C_{rss}	$V_{DS}=20\text{V}, f=1\text{MHz}$		80		pF
ターンオン遅延時間	$t_{d(\text{on})}$			30	60	ns
立ち上がり時間	t_r	$I_D=5\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$		90	180	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(\text{off})}$	$V_{CC}=200\text{V}, R_{GS}=50\Omega$		250	500	ns
下降時間	t_f			80	160	ns

スイッチングタイム測定回路



外形図 2056
(unit: mm)



SANYO: TO3PB

注: ゲート-ソース間には保護回路ダイオードが入っていないため 取扱いに十分注意すること。